

2022年4月20日

## 東京農工大学への当社製 Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 用 MOCVD 装置設置および稼働開始のお知らせ

大陽日酸株式会社（社長：永田 研二）は、国立大学法人東京農工大学の熊谷義直教授の研究室に研究開発用 MOCVD 装置を設置しましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 背景

β 型酸化ガリウム（β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>）は、シリコンにかわる次世代省エネルギー素子（パワーデバイス）向けの半導体材料として注目されています。当社と東京農工大学は、2020年10月より有機金属気相成長（MOCVD）法による β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 薄膜成長に関する共同研究を開始し、2021年3月には、これまで困難とされてきた β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> の有機金属気相成長に成功いたしました。今後は当社が開発した酸化物向け MOCVD 装置（フローチャンネル部：特許取得済）を用いることで、複雑なデバイス構造が製作可能となり、当該材料の研究開発がさらに活発化していくことを期待しております。

当社では同大学との共同研究を通じて、更なる省エネルギー化を促進しカーボンニュートラル社会の実現に貢献するとともに、当社製 MOCVD 装置の優位性をさらに高めてまいります。

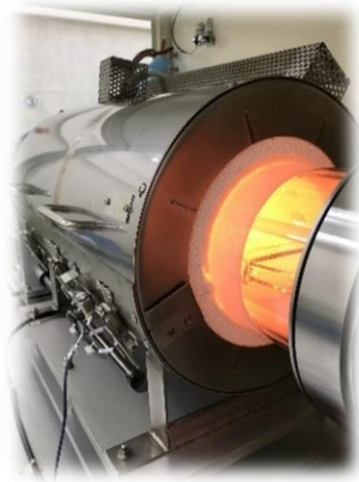
#### 2. MOCVD 装置の概要

- ・ 処理能力： 2 インチ径 1 枚
- ・ 型 式： FR2000-0X
- ・ 特 徴： β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 基板上への高性能電子デバイス用の研究に必要な厚膜ならびに多元混晶成長のニーズに応える高純度・高速成長可能な酸化物向け MOCVD 成長炉

以 上



FR2000-0X 装置外観



FR2000-0X 反応炉（加熱中）

本件に関するお問い合わせ  
大陽日酸株式会社  
東京都品川区小山 1-3-26  
広報部  
TEL: 03-5788-8015  
Mail: Tnsc. Info@tn-sanso. co. jp